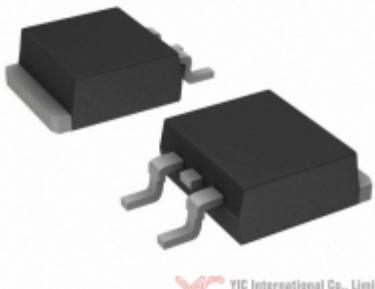


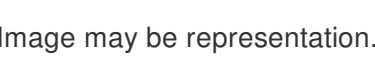








	<b>FQB8N90CTM</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQB8N90CTM
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 900V 6.3A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQB8N90CTM.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 78443 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FQB8N90CTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 6.3A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	78443 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 6.3A (Tc) 171W (Tc) Surface Mount
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	171W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 3.15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQB8N90CTMCT

FQB8N90CTM ist neu im Original, Suche FQB8N90CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB8N90CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB8N90CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQB8P10TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 8A D2PAK</p>	 <p><b>FQB8N80</b> Fairchild/ON Semiconductor FQB8N80 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB8N60CTM_WS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A</p>	 <p><b>FQB8P10TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 8A D2PAK</p>
 <p><b>FQB8N60CTM-WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A</p>	 <p><b>FQB8N90CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.3A D2PAK</p>	 <p><b>FQB8P10TM-NL</b> VB FQB8P10TM-NL VB</p>	 <p><b>FQB8P10</b> FAIRCHI FQB8P10 FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQB6N70TM	↔ FQB6N90TM	⇒ FQB6N90TM_AM002	D FQB6N90TM_AM002	↔ FQB7042FB
↔ FQB7045FB	⊛ FQB70N03	D FQB70N06	⇒ FQB70N08	↔ FQB70N10TM
⊛ FQB7N10L	↔ FQB7N20L	⊛ FQB7N60TM	↔ FQB7N60TM	↔ FQB7N65C
D FQB7N65CTM	⊛ FQB7N65CTM	↔ FQB7P20TM	⊛ FQB7P20TM	↔ FQB85N06
⇒ FQB85N06TM	↔ FQB8N25TM	⊛ FQB8N25TM	↔ FQB8N60C	↔ FQB8N60CFTM
↔ FQB8N60CFTM	⇒ FQB8N60CTM	D FQB8N60CTM	⊛ FQB8N60TM	↔ FQB8N90CTM
⊛ FQB8P10TM	D FQB8P10TM	⇒ FQB8P10TM-NL	↔ FQB9N08L	↔ FQB9N08LTM
↔ FQB9N08LTM	⊛ FQB9N25C	↔ FQB9N25CTM	⇒ FQB9N25CTM	↔ FQB9N25TM
⊛ FQB9N25TM	↔ FQB9N50C	⊛ FQB9N50CFTM	D FQB9N50CFTM	↔ FQB9N50CTM
↔ FQB9N50CTM	⊛ FQB9N50TM	↔ FQB9N50TM	⊛ FQB9P25TM	↔ FQB9P25TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

